特集:次世代 EO 素子開発の最前線 2

有機・シリコン融合フォトニクスによる オンチップ超高速光通信デバイス

最先端ナノ光デバイスが 性能限界を打破する

情報通信システムの巨大化が進むなかで、どのように消費電力の増大を抑えながら、ICT機器の小型化や通信速度の向上を実現していくかが、極めて重要な課題となっています。この問題に対し、私たちは「有機材料とシリコンフォトニクスとの融合」が光信号処理の超高速化や低消費電力化、集積化に画期的なブレイクスルーをもたらすと考え、独自の視点から有機・シリコン光集積回路の研究開発を進めています。



光デバイスの課題

情報通信処理の光化が進めば、処 理速度や発熱の問題が解決されるだ けでなく、消費電力についても大 幅に削減できます。しかしこれま で、光ファイバー通信などの長距離 伝送用途以外ではほとんど光化は進 んでおらず、システムの信号処理部 分では、いまだに電子回路に頼って います。これには様々な要因があり ますが、特に大きな問題は、光デバ イスが電子デバイスと比べて桁違い にサイズが大きいこと、そして高価 なことです。つまり、光デバイスの 性能が高いことは間違いないのです が、それだけで普及するわけではな く、サイズやコスト面も含めたトー タルな価値が電子デバイスを上回ら なければ、特殊用途以外、広く使わ

ナノICT研究室 主任研究員

井上 振一郎

Shin-ichiro Inoue

博士(工学)

学歴

2004年 東京工業大学博士課程修了

略歴

2004年、理化学研究所基礎科学特別研究員、 2007年、九州大学先導物質化学研究所助教を経て、 2010年より現職。神戸大学工学研究科准教授、連 携講座)、および理化学研究所客員研究員を兼任。 船井情報科学奨励賞、安藤博記念学術奨励賞、光 科学技術研究振興財団研究表彰など受賞。

研究分野

光エレクトロニクス、ナノ微細加工、有機非線形光 学、ナノフォトニックデバイス

近況

ハードな毎日なのでオフの切り替えは大事にしています。5歳と1歳になり日々成長していく息子たちと過ごす時間が、何より活力を与えてくれます。

れる技術には決してなり得ません。

情報処理の光化を進めるには、複雑な論理処理に優れた電子集積回路と、高速化・省エネルギー化に有利な光集積回路とを融合する技術の開発が不可欠です。そこで特に重要になるデバイスの1つが、電気信号を光信号に変換する光変調器です。現在は、電気光学効果が大きいニオブ酸リチウム(LN)が主に用いられ40Gbpsの光変調器が実用化されています。

また、有機電気光学(EO)ポリマーを用いた光変調器も近年盛んに研究されています。2000年代初頭にはLNをはるかに超える材料性能をもつ有機EOポリマーがワシントン大学のグループによって開発され、2007年にはアリゾナ大学のグループからLNの5倍以上の材料性能(EO係数170pm/V)をもつEOポリマー変調器が報告されています。そして、米国Gigoptix社からは100Gbpsという超高速な有機EOポリマー変調器がすでに商用化されています。

しかし、これらの光変調デバイスはすべて、サイズが数cm以上であり、電子デバイスと比較すると桁違いの大きさです。電子デバイスでは微細化が極限まで進んでおり、フィンガーサイズのチップに数十億個のトランジスタ素子が集積化されています。そのため、1素子あたりのコストも非常に小さくなります。よって、光デバイスが電子デバイスに置き換わるためには、帯域などの性能向上だけでなく、電子デバイスとのサイズ、コスト面のギャップをどの

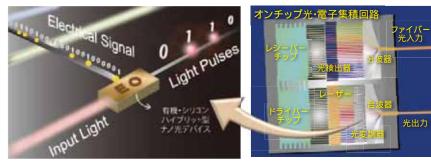


図1 超高速・光/電子融合集積チップの概念図。

ように埋めるかがきわめて重要な課 題となります。

シリコンフォトニクス

このような光デバイスと電子デバイスのサイズ、コストのギャップは「シリコンフォトニクス」という新たな技術分野の登場により、その差が急速に埋まりつつあります。シリコン(Si)はご存じの通り電子デバイスの根幹をなす材料ですが、光デバイスにおいても2000年代以降、国家プロジェクトや産業界が牽引する形で開発が本格化し、瞬く間にシリコンフォトニクスが最注目の技術分野として認識されました。

従来、シリコンは電気光学効果を もたず、材料の特性上、受光・発光 素子としても適さないため、光デバ イスには不向きな材料として長年ほ とんど無視されてきました。しかし、 近年のデバイス構造の最適化や微細 加工・プロセス技術の発展によって、 高速なシリコン光変調器や光検出器 などの要素技術が次々と開発され、 光と電子素子を融合する、現実的な 技術として期待されています。

シリコンフォトニクスの大きな利点のひとつは、屈折率の差を大きくとれるため、従来の石英系やポリマー系の光回路と比べて、その回路サイズや断面積を約1/1000に小型化できることです。その結果、電子

回路と同じチップ上に光回路を集積 化するような技術が可能になります。 また、シリコンフォトニクスのもう ひとつの大きな特徴は、シリコン LSIチップを製造するための施設で あるCMOSファウンドリーを転用 して、大規模な光集積回路を圧倒的 に低いコストで製作できることです。 これは応用上とても重要な要素で、 将来的には単純なLN、EOポリマー 光変調器などの従来の非集積型光デ バイスのほとんどはシリコンフォト ニクスに置き換えられる可能性があ ります。

電子デバイスの性能が限界に近づきつつある現在、CPUのメニーコア化や電気配線の複雑化による信号遅延、発熱量の問題が顕在化しています。このため、電気メタル配線の代わりに、光インターコネクションという、シリコン光配線・光回路を用いる短距離・オンチップ高速光通信技術の開発が急速に進められています。

有機材料とシリコンフォトニクスと の融合

シリコンフォトニクスは集積化に優れ、大規模光回路の大量生産、低コスト化が期待できますが、シリコンはEO効果をもたないため、光変調の動作原理としてキャリアプラズマ効果(キャリア濃度の密度変化)

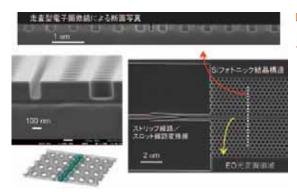


図 2 有機・シリコン融合型ナ ノフォトニック EO 変調デバイ スの電子顕微鏡 (SEM) 写真。

現することで、ナノ領域で光を閉じ込めることも可能になります。

したがって、シリコ ンフォトニクスと有機

材料、両技術のメリットを融合する ことで、超高速な光制御デバイスの 集積化を実現することができると考 えています。

を利用しており、動作速度としては 40GHz前後が限界となります。よって、将来100GHz以上の超高速な光 変調素子の集積化を実現しようとした場合、まったく新しい光デバイスのデザインが必要となります。

現在、産業界では、10Gbpsもしくは40Gbpsの光信号を、波長・偏光・空間的に多重・並列化することによって高速データ通信を実現しようと開発を進めています。しかし、情報通信量(トラフィック)の急拡大を背景に、近い将来、必ず根本的な速度の向上、つまり100GHz以上の超高速な光集積回路が必要になる時期が来ると想定されます。

そこで私たちは、これらのバリ アーを打破するため、有機材料(EO ポリマー)とシリコンフォトニクス とをハイブリッドしたナノフォト ニックデバイスの研究開発を進めて います。EOポリマーはLNよりはる かに大きな非線形光学特性をもって いるので素子の低電圧化が可能であ り、さらに光波と高周波帯の屈折率 差がきわめて小さいため、100GHz ~ THzにいたる超高速な光変調が 可能です。一方で、有機材料は屈折 率が小さいため、従来、集積化には 向かないと考えられてきました。し かし、有機材料は、様々な異種材料 と組み合わせることができるため、 シリコンとのハイブリッド構造を実

スローライトやシリコンナノテクノ ロジーを駆使したデバイス開発

このようなナノフォトニック構 造では、「スローライト」という光 の速度を1/100程度まで人為的に減 速させた極限的な光状態をつくり出 すことが可能です。これにはフォト ニック結晶という光波長程度の周期 構造を利用するのですが、スローラ イト効果を用いることで、物質の非 線形光学効果が大幅に増強されま す。したがって、光デバイスのサイ ズをさらにコンパクト化するととも に、大幅な低消費電力化が可能です。 これらの技術を複合すれば、電子デ バイス並みに光デバイスを極小化し、 ワンチップ上で電子集積回路のボト ルネックとなっている部分を光に置 き換えた究極の超高速・光/電子融 合集積デバイスの開発も可能になり ます(図1)。

私たちは、有機材料の開発、製膜・分子配向プロセスから世界最高精度のシリコンナノ微細加工技術、ナノ光デバイスの性能評価や理論解析にいたるまで、全行程の研究開発を一貫して行っています。このような有機・シリコンフォトニクス融合研究

を総合的に進めているグループは、 世界的にみても未来ICT研究所が唯 一です。

研究開発の現状と展望

現在、私たちは、有機EOポリマー とシリコンナノフォトニック構造を 融合させるプロセス技術を独自に開 発し、ナノオーダーで高精度な有 機・シリコン融合型ナノフォトニッ クEO変調デバイスの作製に成功し ています(図2)。また、シリコンフォ トニック結晶構造によるスローライ ト効果と有機材料の優れたEO特性 を融合することで、現在実用化され ているLN光変調器の10倍以上の性 能指数(電気光学係数)をもち、素 子サイズが従来の1/1000以下のシ リコン・有機EOポリマー融合型フォ トニック結晶EO変調器の動作実証 にはじめて成功しています。

シリコンフォトニクスによるエレ クトロニクスとフォトニクスの本格 的な融合は、情報通信技術に根本的 な変革を引き起こす可能性がありま す。その中で私たちは、シリコン フォトニクスと有機材料の融合を キーワードとし、双方の長所をリン クすることで、従来の光素子では不 可能だった、様々な新しいオンチッ プ光技術への展開をはかっていきま す。100Gbpsを超える超高速光変 調デバイス、光・電子融合集積回路 の開発以外にも、全光スイッチング や光バッファー、超高感度センサー、 さらにはバイオフォトニクス応用な ど、広範な分野・領域への波及効果、 展開が見込まれます。